BEST AVAILABLE COPY

SOLAR CELL

Publication number: JP3239375
Publication date: 1991-10-24

Inventor:

KAWAKAMI SOICHIRO; FUKAE KIMITOSHI

Applicant:

CANON KK

Classification:

- international:

H01L31/04; H01L31/042; H01L31/04; H01L31/042;

(IPC1-7): H01L31/04; H01L31/042

- european:

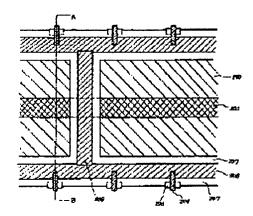
Application number: JP19900035272 19900216 Priority number(s): JP19900035272 19900216

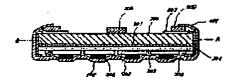
Report a data error here

Abstract of JP3239375

PURPOSE:To attain a simplification of configuration, a reduction of cost, and integrations performed in parallel by providing a bus bar for collecting currents, which is a good conductor having the lower specific resistance than the one of stainless steel, in the middle of the side opposed to an incident light of a stainless steel board.

CONSTITUTION: A solar cell comprises a stainless steel board 200, a metallic layer 201 as a lower electrode, a semiconductor layer 202 as a photoelectric converting member, a transparent electrode layer 203 as an upper electrode, finger electrodes 204, a bus bar 205 for collecting currents caused from the lower electrode 201, a bus bar 209 for connecting the finger electrodes 204 of solar cell elements with each other, and the like. In this manner, the bus bar 205 for collecting currents, which is a good conductor having the lower specific resistance than the one of stainless steel, is provided in the middle of the lower side of the stainless steel board 200. Thereby, a simplification of configuration, a reduction of cost, and integrations performed in parallel can be attained.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-239375

⑤Int.Cl. 3
H 01 L 31/0

織別記号

庁内整理番号

(3)公開 平成3年(1991)10月24日

H 01 L 31/04 31/042

7522-5F H 01 L 31/04

S

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全9頁)

9発明の名称 大陽電池

②特 願 平2-35272

②出 願 平2(1990)2月16日

@発明者 川上 総一郎 @発明者 深江 公僚 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

②出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

個代 理 人 弁理士 丸島 億一 外1名

明知者

1. 発明の名称

大路思油

2. 特許請求の範囲

ステンレス 悲坂上に 金属電後層、 半導体層、 透明 電極層。 フィンガー 状電極 が 順次 形成 された 太陽 電池 素子 を並列 接続した 太陽 電池 に於て、 入射 光 側 と 反 対側 の ステンレス 基板 の 中央 に、 集 電 用 と して ステンレス より 比抵抗が 低い 良 準体 の バス バーが 散けて あること を 特 像 と する 太陽 電池。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ステンレス基板上に形成された大陽 電池素子を並列に接続した大陽電池に関する。

吸近、CO,の増加による温度効果で地球の温 暖化が生じることが予測され、クリーンなエネ ルギーの要求がますます高まっている。また、 CO,を排出しない原子力発電も、安全性を疑問 視する声もあり、より安全性の高いクリーンなエ ネルギーが望まれている。

将来期待されているクリーンなエネルギーの中でも、特に太陽電池はモのクリーンさと安全性と 取扱い品さから期待が大きい。

各種太陽電池の中で、非品質シリコンや銅インシュウムセレナイド等は大面積に製造でき、製造コストも安価であることから、熱心に研究されている

更に、 太陽電池の中でも、 安価で、 耐候性、 耐 街撃性、 可とう性に優れていることから、 基板材 にステンレス等の金属基板が用いられている。

提来、ステンレス基板上に形成された太陽電池 素子を並列配線した太陽電池では、電流損失をできるだけ少なくするためにステンレス基板面の両 場部に下部電極のための集電用バスバーが設け られていた。上記集電用バスバーの材料として は、ステンレスの比越抗のI/20~1/50の A 2, C u . A 8 等が使用される。第 4 図は従来 のステンレス基板面の両端部に集電用バスバーが 設けられた太陽電池素子の構略図で、(a)と

(b) はそれぞれ光入射網の表面と裏面の平面図 である。第4図に於て、400はステンレス基 板、405は下部電極側集電用パスパー、410 は同一ステンレス基板上に分割された太陽電池袋 子、404はフインガー包極である。故パスパー は、損触抵抗を下げ確実な導通を取るために、大 1階電池素子の分離された非発電部位のステンレス 遊板面両端部にスポット裕接などの方法で、多点 接続されていた。第5図は、第4図に示した同一 ステンレス基板上に分割された複数の太陽電池素 子を、並列に集積化した太陽電池の概略図で、 (a) は光入射側の平面図、(b) は裏面の平面 図、(c)は(b)図C-D間の断面構成図であ る。第5回に於て、400、404、405、 410は第4図に同じ、501は下部電極として の金属層、502は光電変換部材としての半導 体層、503は上部電極としての透明電極層、 505はステンレス基板両端にある下部電板集電 用パスパーを接続するパスパー、509は復数 の太陽な池君子のフィンガー電板をつなぐバス

そのため、より簡単な構成で、製造コストの安 価な太陽電池が望まれていた。

(発明の目的)

本発明は、上述の従来の欠点を解決し、簡単な 構成で、製造コストの安価な、並列に集積化した 大陽電池を提供することを目的とする。

(発明の構成及び作用)

本発明者は、上記従来の欠点を解決すべく、鋭

3

窓研究を重ねた結果、並列に集積化したステンレス基板大陽電池に於て、入射光と反対側のステテンレス基板中央部に下部電極からの集電用パスパーを設けることによって、提造が簡単で一本のパステントないとを見いだした。本発明は、ステンレス基板上に金属電極圏、半導体層、透明電池を大路電池に大路電池にステンレスより比低抗が低い良源体のパスパーが設けてあることを特徴とする大路電池である。

第1図は、本発明による太陽電池のステンレス あ板に設けた集電用パスパーを示した図である。 第1図に於て、100は太陽電池裏面のステンレス あ板、105は下部電極からの集電用パスパー である。

第2図(s)は、本発明により作製される並列に集験化した太陽電池の裏面の平面図の一例で、(b)は(s)図A-B関の断面構成図である。第2図に於て、200はステンレス基板、201

は下部電極としての金属階、202は光電変換部材としての半導体層、203は上部電極としての透明電板間、204はフィンガー電極、205は下部電極からの集電用バスパー、209は複数の大陽電池素子のフィンガー電極をつなぐバスパー、208は複数本の209をまとめて集電するバスパー、206は209と200のステンレス遊板が導通するのを防ぐための絶縁性樹脂、207は208と200、205の導通を防ぐための絶縁材である。

本発明による第2回の太陽電池の作製方法を以下に説明する。ステンレス基板200に、金属層201、半導体層202、透明電極層203を脱水形成した太陽電池の透明電極層の一部を除去して、複数の太陽電池素子に分削する。次に、各大陽電池素子の透明電極上にフィンガー電極204を形成した後、裏面のステンレス基板面に、テープ状点導体から成るバスパー205を設置する。ついで、絶縁樹間206と絶縁材207で基板場面及び境部を被覆する。フィンガー電板204か

5の電波を最終的にまとめて集電するパスパー208を絶縁材207上に設ける。その後、芸坂上で同じ列に位置する太陽電池素子を並列接続するパスパー209をフィンガー電極204とパスパー208に接続して、本発明の太陽電池を得る。パスパー205と208は出力端子になる。

本発明により、下部電板集包用バスバーをステンレス基板の両端から等距離の位置に設けることによって、従来の下部電板集電用バスバーの本数を2本から1本に減らすことができ、かつ上部電板の表でも、から最終的に集電するバスバーを、絶縁部を介して下部電板集電用バスバー上に重ねて設けなくてもよいので、作割される太陽電池の凹凸も減少する。そのため、充塡剤の使用量が少なくてすみ、そのユール化も容易になる。一般に長さし、中W・厚さt・比紙抗pの基板中での魅力扱失は

で表わされる。ここで 1 は太陽電池の単位面積当 りの発生電流である。太陽電池に於て特徴的なこ

•

の、コストが上ってしまう。

本発明に用いられる下部電極集電用バスバー105.205は、良塚体材料から成り、ステンレスより比抵抗の低い良塚体材料としては飼、銀、ニッケル等の金属箔が用いられる。金属箔は他の金属やハンダがメッキされていてもよい。他のバスバー208.209いずれも、上記本発明に用いられるバスバー105.205と同様の良塚体材料から成っている。

206の絶疑樹脂には、ポリエステル、ポリエ

とは、発電部各所で発電が行われるため、セル及 さが長くなるに従って既流が増えて来る。その結 果、電力損失は電流路長(L)の3型で効いてき てしまう。

本来であれば、ステンレス芸板も導電体であるので、追加のバスバーを使わずに済ませたいのだが上記理由により難しい。

さて、ステンレス装板での電力損失を減少させるべく、第6図の如く良導体バスパーをとりつけると、電力損失はよ(x)に比例する。

$$f(x) = x^{3} + (L-x)^{3}$$

$$f'(x) = 3x^{2} - 3(L-x)^{3} = 0$$

$$x^{3} - x^{3} + 2xL - L^{2} = 0$$

 $x = \frac{L}{2}$

従って×= L/2の時に、短力損失は最小になる。 従来の技術に見られる様に基板両側に2本配便しても電力損失は同様になるが、上述の様な欠点をもってしまう。しを小さくする為に多数のバスバーを配置すれば電力損失は小さくなるもの

8

ステルイミド、ポリイミド、ポリウレタン、シリコーン、エポキシ、アクリル制脂等がある。 206の絶縁制脂の形式方法は、樹脂溶液のスプレーやディップ法による塗布、粘着材付き樹脂フィルムを貼付ける等の方法がある。

2 0 7 の絶縁材には、粘着剤付きガラスクロス テープやポリイミドチーブ等が用いられる。

本発明で用いられる太陽電池素子の金属電板層 201の材質としては、Ti, Cr, Mo, W, A.A. A.S. Ni等が用いられ、形成方法として は抵抗加熱蒸着。電子ビーム蒸発、スパッタリン グ法等がある。

本発明で用いられる太陽電池素子の光電変換節材としての半導体層202には、pin接合非晶質シリコン。CuinSe、/Cds等の化合物半導体が挙げられる。上記半導体層は、非晶質シリコンの場合、シランガス等のブラズマCVDにより、多結晶シリコンの場合、溶脱シリコンのシート化により、CuinSe、/Cdsの場合、電子ビーム蒸発、ス

パッタリング、 選折 (電解液の電気分解による析出)等の方法で、形成される。

本発明で用いられる太陽電池素子の透明電極 203に用いる材料としては、ln。O。. 5nO。.ln。O。一SnO。.ZnO.Ti O。.Cd。SnO。.高濃度不純物ドーブした 結晶性半導体層等があり、形成方法としては抵抗 加熱蒸着、電子ビーム蒸煮.スパッタリング法. スプレー法.CVD法.不純物拡散等がある。透 明電極203の一郎を除去して太陽電池素子に分 離する方法は、FeCa。.HCaを含むエッチ ングベーストのスクリーン印刷等でパターンニン クする。

フィンガー 電低 2 0 4 は導電性 樹脂で形成され、導電性 樹脂は、 微粉末状の鏝。 金、銅。 ニッケル・カーボン等をパインダーボリマーと 分散させたものが使用される。上記パインダーボリマーとしては、ポリエステル、エポキシ、アクリル、アルキド、ポリビニルアセテート、ゴム、クレタン、フェノール等の 樹脂がある。フィンガー電板

1 1

那を認識して、透明電低除去部上の下部電極集電 用パスパーの位置に、レーザー発振器から光ファ イパーで伝送したレーザー光を照射して集電用パ スパーをステンレス基板と接合する。

第2図の構成の本発明の大陽電池に於て、半導体層が非晶質シリコンである場合の、作製方法を 順次設明する。

まず、洗浄したロール状ステンレス芸板上に、ロールツーロール法で、SIを1%含有するAを201をスパッタ法により限厚5000人蒸着し、SIH。PH。.B。H。.H。がス等のブラズマCVDにより、股厚1000~4000人のP/I/nの非晶質シリコン暦を2個積み低力でである。MEをBをしての半導体層202を形成した後、膜厚800の1TO203を抵抗加熱蒸着で形成した。更に、ITOのエッチング刻(FeCa,.HCa)合有ペーストのスクリーン印刷によりITO層の一部を除去し、各太陽電池表子のA2201と非晶質シリコ

204は、上記述就性樹脂のスクリーン印刷等の方法で作製される。フィンガーな優204と上部

花橋側集電バスパー209は、逐気性接着剤など
で接合される。

バスパー209と208は導電性接着剤、ハンダ、レーザー指接などで、接続される。

(実施例)

以下、 突筋 例に 基づき 太 発明を詳細 に 説明 する。 なお、 本 発明 はこれらの 実施 例に 限定 されるもの ではない。

第3図は本実施例の下部電極集電用バスバーをステンレス基板に接続するための一方法として使用するレーザー溶接級の機略図である。第3図に於て、300は太陽電池素子の形成されたステンレス基板、301は下部電極側集電用バスバー、302はレーザー光、303は出射光学系、304は光ファイバー、305はレーザー発振器、306はテレビカメラあるいはイメージセンサー、307は移動可能なステージであり、テレビカメラ306で太陽電池素子の透明電極除去

1 2

ン暦 2 0 2 との間にシャント防止層として 2 g D を形成してもよい。)

次に、フィンガー幅0、2mmのフィンガー電 伍204を銀ペーストのスクリーン印刷で形成し た。その後、光入射と反対側のステンレス基板中 央郎に揺19mm、厚み0、2mmの飼箔テープ 205を配置し、第3図のレーザー溶接機を用い て、光入射側のITO除去部下部に位置する網箔 郎に、レーザー光を照射し接合した。ついで、 ステンレス基板両端部の端面を覆うようにポリイ ミドテープ206を接着し、ガラスクロステープ 207を基板裏両端部に接着して、幅12mm, 氏み0. 2mmの銀箔テープ208をガラスクロ ステープ207上に接着した。更に、表側フィン ガーは極204に、幅2.5mm、厚み0.1 mmのハンダメツキを施した銅符209を浮電性 接着剤で接続した後、銅箔209の阿末蛸即を 208にレーザーで接合して、太陽電池君子を 複数個並列級統した太陽電池を得た。また、上記 作製方法で17cmのサブセルのフィンガー信様

204を6個的語20gで並列に接続したものを更に10個並列接続した場合、AM1.5 100mW/c㎡の完照射時の開放輸缸圧Vocと短時電流Iscは、それぞれVoc=1.6 V.1sc=4.8Aであった。

(発明の効果)

本発明によれば、従来のステンレス基板上に形成した大陽電池素子を、並列接続して集積化した 構成の大陽電池の欠点を解決し、集成パスパーの 接続構造を簡単にすることによって、配線部の凹 凸が小さくなり、モジュール化も容易になる。さ らに製造工程の簡略化が可能になり、製造コスト を低減できる。

・4. 図面の筒単な説明

第1回は本発明の太陽電池のステンレス基板に 取り付けた下部電極関楽電用パスパーを説明する ための構成図、

第2図(a)(b)は太癸明により作製される 太陽電池の一例の概略像成図、

第3図は本発明の実施例に用いたレーザー路接

1 5

- 3 0 4 -- 光ファイバー
- ` 3 ⋅0 5 ⋅・・ レーザー発援器
- 3 0 6 ... テレビカメラ
- 307…レーザー溶接用作業ステージ
- 300…太陽電池の形成されたステンレス基板

出願人

キャノン株式会社

代理人

丸 鳥 ()) ---

西山东三

梭の例の概略図、

第4図(a)(b)は従来の太陽電池素子が形成されたステンレス基板に設けられた下部電板側 集電用パスパーを示す図、

第5図(a)(b)(c)は従来の複数の大幅 電池案子を並列接続した太陽電池の優略構成図、

第6回は見力損失を説明するための概念図である。

100,200,400…ステンレス基板

105, 205, 208, 209, 301,

405, 508, 509 m K A K ~~

201,501…金属層

202.502…半導体層

203,503…透明電極層

204,404…フィンガー電信

206.506…絶疑樹脂

207.507… 絶縁材

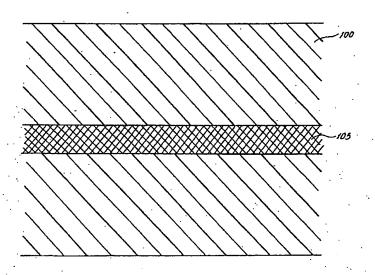
410…分離された太陽電池素子

302 ... レーザーギ

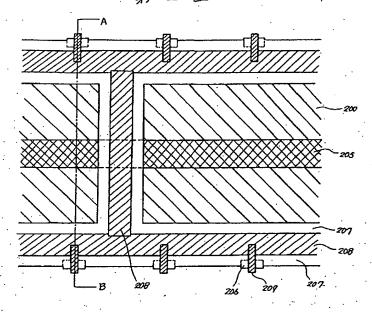
303…出射光学系

1 6

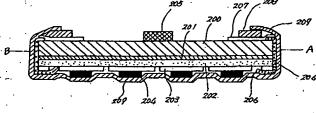
第1图



第2図(a)

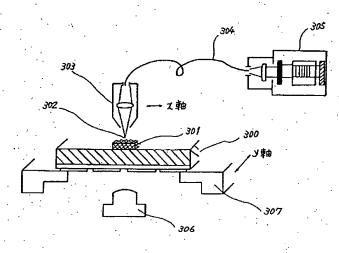


205 707

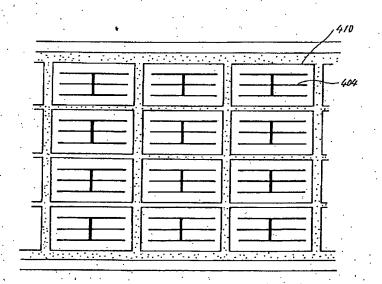


---456---

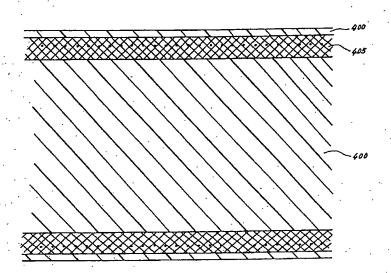
第3図



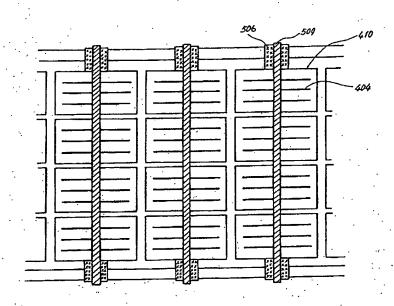
第 4 図(a)



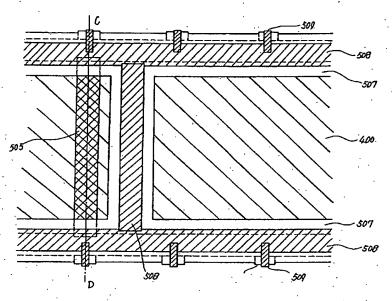
第 4 図(b)



第5図(a)

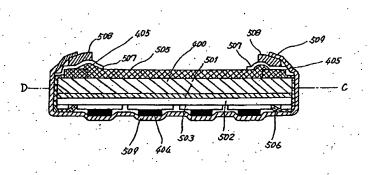


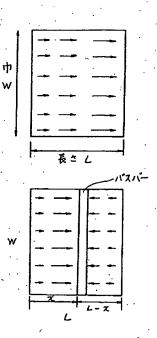
第5図(6)



第 6 図

第5図(0)





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
\square image cut off at top, bottom or sides
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
·

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.